

Предварительная программа XIV МНТК МНТЭ

Секция 1. Физико-химические свойства материалов и структур микро- и нанoeлектроники

- 24-01. Влияние высокого давления на кинетические характеристики $\text{Cd}_3\text{As}_2 + 3 \text{ мол. \% MnAs}$.
Камилов И.К., Сайпулаева Л.А., Риль А. И., Маренкин С.Ф.
- 24-05. Investigation HoAs-HoTe system. *Mammadova N., Sadygov F.*
- 24-06. Естественный размерный эффект в гетероконтактах III-нитридов. *Филимонов А.В., Бондаренко В.Б., Королева Е.Ю., Кузнецов Д.И.*
- 24-18. Электрофизические свойства пленок оксида цинка, легированного алюминием, синтезированных методом спрей-пиролиза. *Свистова Т.В., Рембеза Е.С., Кошелева Н.Н., Белых М.А., Пермяков Д.С., Конев М.Д., Чурилов Д.В.*
- 24-19. Электрофизические и оптические свойства пленок SnO_x , синтезированных методом спрей-пиролиза. *Кошелева Н.Н., Рембеза Е.С., Свистова Т.В., Белых М.А., Пермяков Д.С.*
- 24-24. Исследование соотношения колебательных кремний-водородных мод в слое \square -Si:H методом ИК-спектроскопии нарушенного полного внутреннего отражения. *Панов М.Ф.*
- 24-25. Фурье-анализ спектров отражения приборных SiC-структур: принципы и границы применимости метода. *Афанасьев А.В., Панов М.Ф., Рыбка М.В., Ульченко Т.И., Васильев Е.А., Фирсов Д.Д.*
- 24-26. Модель тепловых процессов в нанопористой структуре оксида алюминия с наполнителем. *Кармоков А.М. Козырев Е.Н., Кармокова Р.Ю., Молоканов О.А.*
- 24-27. Расчет распределения тепловых потоков и температуры в нанопористой структуре алюминия. *Кармоков А.М. Козырев Е.Н., Кармокова Р.Ю., Молоканов О.А., Лосанов Х.Х.*
- 24-28. Расчет параметров пироэлектрического стержня в нанопористой структуре оксида алюминия. *Хатукаев Х.М., Карданов Л.А., Кармоков А.М., Козырев Е.Н., Кармокова Р.Ю., Молоканов О.А.*

Секция 2. Фазовые равновесия и превращения в материалах электронной техники

- 24-02. Фазовые превращения $n\text{-CdAs}_2$ в условиях различного давления. *Камилов И.К., Сайпулаева Л.А., Тебеньков А.В., Маренкин С.Ф.*
- 24-10. Микроволновое поглощение и кластеризация в системе хлорбензол – n -бутанол. *Азизов С.*
- 24-22. О гистерезисе температур плавления и кристаллизации в четырехкомпонентных наночастицах. *Вересов С.А., Серов С.В., Колосов А.Ю., Савина К.Г., Мясниченко В.С., Сдобняков Н.Ю.*

Секция 3. Технологии наноматериалов и тонкопленочных структур для микро- и нанoeлектроники

- 24-03. III-V-наноструктуры переменной размерности на кремнии для приложений оптоэлектроники, фотоники и квантовых коммуникаций. *Резник Р.Р., Акопян Н., Илькив И.В., Гридчин В.О., Крыжановская Н.В., Хребтов А.И., Бареттин Д., Цырлин Г.Э.*
- 24-20. Механизмы памяти, переключения и формирования кристаллической фазы в халькогенидах $\text{Ge}_2\text{Sb}_2\text{Te}_5$, используемых в энергонезависимых ячейках памяти нового поколения. *Смирнов А.Г., Троян Е.И., Степанов А.А., Кузьмин А.А.*
- 24-21. Наноструктурирование как метод управления оптическими свойствами тонких пленок. *Степанов А.А., Смирнов А.Г., Кузьмин А.А.*
- 14.23. К проблеме обработки изображений поверхности тонких металлических пленок. *Анофриев В.А., Антонов А.С., Семенова Е.М., Кузьмин Н.Б., Сдобняков Н.Ю.*

Секция 4. Приборы и устройства. Информационные технологии в микро- и нанoeлектронике

- 24-04. Разработка и исследование диодов с низким падением напряжения. *Пригодский Д.М.*
- 24-11. Сравнение реализации модели термического окисления кремния на языке программирования MS Visual C# и в САПР TCAD. *Плотникова Е.Ю., Арсентьев А.В., Винокуров А.А.*

- 24-13. Исследования и разработка эмиссионных приемников изображений архитектуры ЭОП, чувствительных в спектральной солнечно-слепой ультрафиолетовой части оптического диапазона. *Беспалов В.А., Демидова А.Н., Ильичёв Э.А., Корляков Д.А., Куклев С.В., Петрухин Г.Н., Попов А.В., Рычков Г.С., Соколов Д.С., Чистякова Н.Ю., Финогеев Н.В., Якушов С.С.*
- 24-14. Разработка одноканального двухспектрального эмиссионного приёмника изображений, чувствительного в спектральном диапазоне 150...300 нм и осуществляющего привязку изображений УФ-С-объектов к ИК-изображению окружающей объекты местности. *Беспалов В.А., Демидова А.Н., Ильичёв Э.А., Корляков Д.А., Куклев С.В., Петрухин Г.Н., Попов А.В., Рычков Г.С., Соколов Д.С., Чистякова Н.Ю., Финогеев Н.В., Якушов С.С.*
- 24-15. 75 лет полупроводниковому транзистору: прошлое, настоящее и будущее. *Иванов А.С., Филимонов Н.А.*